

# Diodes

## Switching diodes

Type	Fig. Nr.	Maximum ratings			Characteristics								Notes
		$I_V$ at $I_{amb} = 45^\circ\text{C}$ mW	$I_F$ mA	$U_R$ V	$R_{thJA}$ $^\circ\text{C/W}$	$U_F$ at $I_F$ V	$I_F$ mA	$C_D$ at $U_R$ pF	$r_f$ at $I_F$ $\Omega$	$t_{rr}$ $\mu\text{s}$			
BA 173	1		300	300	$\leq 450$	$\leq 1$	100	$\leq 2$	150			0,35 <sup>1)</sup>	Clamping diode
BA 176	1					$\leq 1,5$	400						Aerial protection diode <sup>2)</sup>
BA 178	3		100	35	$\leq 400$	$\leq 1,2$	100	$\leq 1,3$	30	$\leq 1,3$	5		RF switching diode
BA 182	3		100	35	$\leq 400$	$\leq 1,2$	100	$\leq 1$	20	$\leq 0,7$	5		RF switching diode
BA 243	2		100	20	$\leq 350$	$\leq 1$	100	$\leq 2$	15	$\leq 1$	10		RF switching diode
BA 244	2		100	20	$\leq 350$	$\leq 1$	100	$\leq 2$	15	$\leq 0,5$	10		RF switching diode
BAW 24	2	440	600	40	$\leq 350$	$\leq 1,2$	200	$\leq 4$	0			0,006 <sup>3)</sup>	
BAW 25	2	440	600	40	$\leq 350$	$\leq 1$	200	$\leq 4$	0			0,006 <sup>3)</sup>	
BAW 26	2	440	600	60	$\leq 350$	$\leq 1,2$	200	$\leq 4$	0			0,006 <sup>3)</sup>	
BAW 27	2	440	600	60	$\leq 350$	$\leq 1,25$	400	$\leq 4$	0			0,006 <sup>3)</sup>	
BAY 68	2	440	115	25	$\leq 350$	$\leq 1$	100	$\leq 5$	0			0,01 <sup>1)</sup>	
BAY 69	2	440	115	50	$\leq 350$	$\leq 1$	100	$\leq 5$	0			0,01 <sup>1)</sup>	
BAY 92	1	230 <sup>4)</sup>	100	600	$\leq 450$	$\leq 1$	100	$\leq 4$	10			0,35 <sup>1)</sup>	
BAY 93	2	440	115	20	$\leq 350$	$\leq 1$	10	$\leq 5$	0			0,015 <sup>1)</sup>	
1N 4148 $\circ$	2	440	200	75	$\leq 350$	$\leq 1$	10	$\leq 4$	0			0,008 <sup>1)</sup>	
1N 4149	2	440	200	75	$\leq 350$	$\leq 1$	10	$\leq 2$	0			0,008 <sup>1)</sup>	
1N 4151 $\circ$	2	440	200	50	$\leq 350$	$\leq 1$	50	$\leq 2$	0			0,004 <sup>1)</sup>	
1N 4154	2	440	200	25	$\leq 350$	$\leq 1$	30	$\leq 4$	0			0,004 <sup>1)</sup>	
1N 4446 $\circ$	2	440	200	75	$\leq 350$	$\leq 1$	20	$\leq 4$	0			0,008 <sup>1)</sup>	
1N 4447	2	440	200	75	$\leq 350$	$\leq 1$	20	$\leq 2$	0			0,008 <sup>1)</sup>	
1N 4448 $\circ$	2	440	200	75	$\leq 350$	$\leq 1$	100	$\leq 4$	0			0,008 <sup>1)</sup>	
1N 4449	2	440	200	75	$\leq 350$	$\leq 1$	30	$\leq 2$	0			0,008 <sup>1)</sup>	

Remarks: <sup>1)</sup>  $I_F = I_R = 10\text{ mA}$ ,  $i_R = 1\text{ mA}$ ; <sup>2)</sup>  $I_R = 1\ \mu\text{A}$ ,  $U_{(BR)} = 100\text{ V}$ ,  $\frac{I_P}{T} = 0,01$ ,  $t_P = 0,3\text{ ms}$ ; <sup>3)</sup>  $I_F = I_R = 10\text{...}100\text{ mA}$ ,  $i_R = 0,1\text{ I}_R$ ; <sup>4)</sup> at  $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$

Data book reference: B 2 B  $\circ$  Can be delivered as "Qualified semiconductor device"

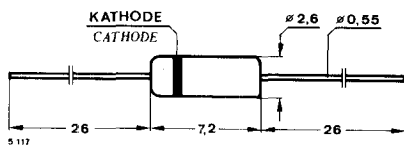


Fig. 1: 51 A 2 DIN 41 880  
JEDEC DO 7

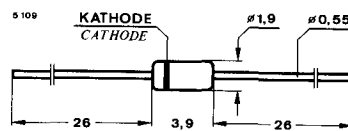


Fig. 2: 54 A 2 DIN 41 880  
JEDEC DO 35

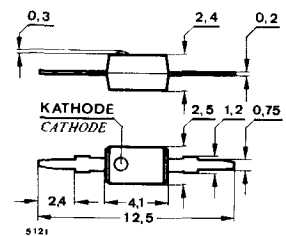


Fig. 3: Plastic case  
SOD 23